

Н.М.Осипова, Р.Херцог

ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ВЕРХНЕЕ КРИТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СПЛАВОВ Nb-Ti после насыщения гелием И Термообработки

Направлено в журнал "Физика низких температур"; Международную конференцию по магнетизму, Франция, 1981; Всесоюзное совещание по радиационной физике твердого тела, Звенигород, 1981 г.

1. Насыщение ниобия и его сплавов ионами гелия и последующий высокотемпературный отжиг с целью образования пор в их объеме вызывают заметные, порой необычные изменения таких свойств, как остаточное сопротивление ρ_n , критическая температура T_c , критическая плотность тока j_c и др. $^{/1-3/}$. Представлялось весьма интересным выяснить, как меняются при этом плотность состояний на поверхности Ферми N(0), температура Дебая θ_D /фононный спектр/ и другие характеристики, которые можно вычислить на основании исследования теплоемкости и некоторых других свойств сплавов.

2. В качестве образцов использовались фольги толщиной 50-100 мкм и шириной 1-1,5 мм из сплавов ниобия с - 3 ат.% и 20 ат.% титана. Равномерное насыщение гелием рекристаллизованных фольг проводилось путем облучения в атмосфере воздуха пучком a-частиц с начальной энергией 29 МэВ²². Режимы рекристаллизации и последующего отжига, а также концентрация внедренного гелия приведены в таблице. В <u>таблице</u> и на рисунках, иллюстрирующих характеристики образцов, приняты следующие обозначения: первое число - номер, второе - концентрация гелия в ат.%, третье - температура послерадиационного отжига в °С, четвертое - время этого отжига в часах.

Теплоемкость C(T) определялась методом измерения времени релаксации⁴⁴.На образец массой 10 ÷ 50 мг с помощью клея БФ-2 крепились: на одной стороне – микронагреватель массой 0,5 ÷ 1 мг, сделанный из константана q' 0,05 мм, а на другой – спай дифференциальной калиброванной термопары. Подводы к нагревателю состояли из четырех медных проволочек q' 0,07 мм длиной 15 ÷ 20 мм. Характерное время изменения температуры после включения /выключения/ нагревателя $r_{\rm r}$ составляло 10-50 с, причем термопара начинала реагировать не позже, чем через 0,5 с.

Масса клея БФ-2, при помощи которого закреплялись микронагреватель и спай термопары, составляла 0,2÷0,4 мг. Теплоемкость образца из клея массой ~ 30 мг, полимеризованного при тех же условиях, была измерена в отдельном эксперименте. При вычислении теплоемкости образцов поправка на теплоемкость клея не превышала 30%, а на теплоемкость нагревателя - 1%. Точность определения теплоемкости сплавов не хуже 6%.

Верхнее критическое поле H_{C2} измерялось резистивным методом в однородном магнитном поле, направленном перпендикулярно плос-

BUBINCTEKA

Таблица

Характеристики образцов, теплоемкость которых была измерена

Сплав	Nb0,97 ^{Ti} 0,03		Nb _{0,8} Ti _{0,2}			
⊯ oop.	4	2	30	61	45	34
Режим рекрист., °С/час	1100/I	1020/1	2 4.	1280/2	1250/2	1250/2
CHe, ar.%	0	0,07	0	0	0,06	0,05
Послерад. отжиг. С/час	-	115 0/1	-		-	1200/I
R ₃₀₀ / Rn	21	7,I	I,6	1,7	I,6	3,0
<i>Ри</i> . мікОм.см	0,85	2,5	22,I	20,2	22,0	8,0
Г _с , К	9,3	9,2	9,6	9,4	9,45	9,4
мііж/мольк ² 8*	., II,0	12,8	16,8	10,1	II,I	12,6
мД ж/ мольк ⁴ В	0,134	0,180	0,167	0,106	0,133	0,148
щ⊯/мольК ⁴ ≪	0,300	0,355	0,341	0,293	0,260	0,248
θ_{o}, K	245	220	230	265	245	235
Ces / Cen	2,27	2,27	°I,80	2,43	I,97	I,68
(dH _{c2} /d T) _z , кЭ/К	I,4	I,8	10,3	9,3	8,9	3,0
расч.Н _{с2} (0), кЭ	9,0	II,5	68,5	60,6	58,3	19,5
экстр.Н _{с2} (0) кЭ	9,2	12,2	68,7	62,0	59,9	20,6

кости образца и току. За $H_{C2}(T)$ принималась величина магнитного поля, полученная путем экстраполяции линейной части зависимости $I_C(H)$ к оси H /величина I_C определялась по критерию $E_C = 1 \frac{MKB}{CM}$ /. Следует отметить, что полученные таким образом



Рис.1. Температурные зависимости Н_{С2}(Т)образцов из Nb_{0.97} Ti_{0.03} /образец №20 - х.д., №21 - рекристаллизованный при 1020°С, №8 облученный и №№3,6,5, 7 - облученные с последующим отжигом/.

значения H_{C2} на несколько процентов ниже по сравнению со значениями H_{C2}, полученными такой же экстраполяц<u>ией зави</u>симости √I_C(H) ⋅ H.

3. Результаты измерения верхнего критического поля $H_{C2}(T)$ для образцов двух составов приведены на <u>рис. 1</u> и <u>2</u>, а в таблице даны величины $(dH_{C2}/dT)_{T_{c}}$, $H_{C2}^{pac4}(0) =$ =-0,693 $T_{C}(dH_{C2}/dT)_{T_{c}}$,

 $\rm H_{C2}\left(0\right)$ /получено путем экстраполяции к T=0 кривой $\rm H_{C2}(T)$ /,критической температуры $\rm T_{C}$ /получено резистивным методом, с измерительным током 1 мА, причем $\rm R(T_{C})/R_{n}$ =0,5/, остаточного удельного электросопротивления ρ_{n} и отношения сопротивлений $\rm R_{300}/R_{n}$. Экстраполяция линейной части кривых $\rm H_{C2}\left(T\right)$ к оси температур дает величины, практически совпадающие с $\rm T_{C}$.

Отметим следующие особенности. Во-первых, для обоих составов облучение приводит к снижению $\rm H_{C2}$ по сравнению с рекристаллизованными образцами. Во-вторых, послерадиационный отжиг влияет по-разному на изменение $\rm H_{C2}$ для $\rm Nb_{0,97}$ Ti $_{0,03}$ и $\rm Nb_{0,80}$ Ti $_{0,20}$ /в первом случае повышает, а во втором – снижает $\rm H_{C2}$ по сравнению с облученными образцами/. Возможные причины такого поведения мы обсудим ниже.

4. Результаты измерения теплоемкости и вычисленных на их основе величин приведены на <u>рис. 3</u> и <u>4</u>, а также в таблице. При определении коэффициентов γ^* и β в выражении C(T)= $\gamma^*T+\beta T^3$

2



Рис.2. Температурные зависимости H_{C2}(Т) образцов из Nb_{0,8} Ti_{0,2} /№30- х.д., №51 - рекристаллизованный при 1000 °С, №31 - рекристаллизованный при 1250 °С, №39 - облученный и №№33, 36,38,34 - облученные с последующим отжигом/.

использовались плотности и молярные веса $8,47 \text{ г/см}^3$ и 91,56 г для $Nb_{0,97}$ $Ti_{0,03}$; 7,75 г/см³ и 83,91 г для $Nb_{0,8}$ $Ti_{0,2}$.3десь $y^* =$ = $\gamma(1 + \lambda)$ – экспериментально определенный коэффициент, а λ – константа электрон-фононного взаимодействия. Температура Дебая $\theta_{\rm D}$ вычислялась по формуле

 $\theta_{\rm D} = \left(\frac{12\pi}{5\beta} \cdot {\rm R}\right)^{1/3} = 100\left(\frac{1.944}{\beta}\right)^{1/3},$

где R =8310 мДж/моль.К - газовая постоянная, β выражается в мДж/моль \cdot К 4 .

Отношение электронных теплоемкостей C_{es}/C_{en} вычислялось при температуре T_C^* , соответствующей середине перехода по теплоем-кости*. Для этого сначала определялся коэффициент α в выражении $C_{es} = C(T) - \beta T^3 = \alpha T^3$, хорошо описывающем экспериментальные результаты при T>0,5 T_C , а затем $C_{es} = \alpha T^3$ и $C_{en} = \gamma^* T$ экстраполировались к T_C^* .

Прежде всего отметим заметное снижение y^* в результате рекристаллизации холоднодеформированного образца. Аналогичное явление наблюдалось также для сплавов Nb - /55 ÷ 65/ ат % Ti /по результатам измерения теплопроводности/. Последующее насыщение ионами гелия приводит к сравнительно небольшому возрастанию y^* .Кроме того, величины скачков теплоемкости при температуре перехода /особенно в случаях холодной деформации /х.д./и отожженного после насыщения гелием образцов/ оказываются заметно ниже теоретически предсказанных / \geq 2,43/ и измеренных экспериментально для хорошо отожженных массивных образцов

* T_c практически совпадала с минимумом на кривых C(T) лричем $(T_a - T_a^*) \le /0, 2 \div 0, 4/K.$





Рис.3. Температурные зависимости удельной теплоемкости образцов из:

а/ Nb_{0,97} Ti_{0,03}/№4 рекристаллизованный при 1100 °C;№2 - облученный с последующим отжигом при 1150 °C/;

б/Nb_{0,8}Ti_{0,2}/№30 - х.д., №31 - рекристаллизованный при 1280 °С, №45 - облученный и №34 - облученный с последующим отжигом при 1200 °С/.

Nb-/10 \div 50/ат % Ti, для которых C_{e8}/C_{en}=2,39 \div \div 2,87^{/5.} Одна из возможных причин такого поведения может быть связана с частичной аморфизацией, приводящей к появлению дополнительного линейного /по температуре/ члена в фононной теплоемкости /см., например, ^{/8/}/, наличие которого повышает измеренную величину y* и снижает скачок.

Для указанных в таблице образцов мы вычислили величины λ , используя формулу Макмиллана $^{/6}$,измеренные





Рис.5. Зависимость $H_{C2}(0)$ от величины 7,5.10⁻³ $\sqrt{\gamma} \rho_n$. $H_{C2}(0)$, полученная путем экстраполяции экспериментальных зависимостей $H_{C2}(T)$ к T=0 K.

значения T_c , θ_D и три значения кулоновского псевдопотенциала $\mu^* = 0,075$; 0,10 и 0,13. Соответствующие средние значения $\lambda = = 0,73$; 0,82 и 0,90 /различия в λ для разных образцов менее 10%/. В качестве примера для рекристаллизованного образца $Nb_{0,8}Ti_{0,2}$ плотность состояний на поверхности Ферми $N(0) = 3\gamma^*/2\pi^2 K_B^2(1+\lambda) = = 0,424$ у*/(1+ λ)=2,52; 2,41 и 2,31 ур./эВ.ат для указанных выше трех значений λ .

5. По теории ^{/6/}, $H_{C2}(0) = \sqrt{2}H_{C}(0)(\kappa_{0}+7,5\cdot10^{-3}\rho_{n}\sqrt{\gamma})$, где $H_{C}(0)$ - термодинамическое поле; κ - параметр Гинзбурга-Ландау для чистого металла / γ дано в эрг/см³ K^{2} , ρ_{n} - в мк0м·см/.

Как видно из <u>рис. 5</u>, связь между экспериментально найденными $H_{C2}(0)$ и $\rho_n \sqrt{\gamma^*}$ практически линейная, причем экстраполяция к $\rho_n=0$ дает $H_{C2}(0)$ порядка 4 кЭ, т.е. величину, которой характеризуется чистый ниобий ^{/8/}.

Снижение H_{C2} в результате облучения для сплавов обоих составов, по-видимому, связано с перестройкой дислокационной структуры недорекристаллизованных образцов, приводящей к уменьшению ρ_n^{max} , которое определяет H_{C2} и относится к областям с повышенной плотностью дислокаций. Именно поэтому H_{C2} снижается после облучения, несмотря на повышение γ^* и среднего значения ρ_n /измеренного экспериментально/. Это предположение подтверждается сильным снижением критического тока у облученных образцов /2,7/, что отвечает уменьшению пространственной модуляции свойств.

Одна из возможных причин сильного уменьшения ρ_n и H_{C2} образцов из Nb $_{0,8} Ti_{0,2}$, наблюдавшееся в ходе послерадиационного отжига при 1150-1200 °C, связана с частичным уходом атомов Ti из матрицы и образованием мелких выделений ^{/7/}. Скорее всего, этот процесс инициируется кислородом, попавшим в образец во время облучения. Из-за малой концентрации Ti в сплаве Nb_{0,97} Ti_{0,03} такой эффект должен быть менее значителен, хотя многочисленные выделения наблюдались и здесь ^{/2/}. Во всяком случае в этом сплаве конкурирующий процесс – повышение среднего значения ρ_n /на 1,5 ÷ 2 мкОм см/ оказывается более заметным. Мы полагаем, что он может быть связан /по крайней мере частично/ с дополнительным сильным рассеянием электронов на выделениях и порах, вокруг которых возможно образование областей напряжений.

6. На основе проведенных нами исследований теплоемкости и верхнего критического магнитного поля фольг из $Nb_{0.97}$ Ti_{0.03} и $Nb_{0.8}$ Ti_{0.2}, последовательно подвергнутых холодной деформации /на 98%/, рекристаллизационному отжигу, насыщению гелием и послерадиационному отжигу, можно сделать следующие основные выводы:

а/ рекристаллизационный отжиг приводит к уменьшению экспериментально найденных значений y^* и повышению θ_D по сравнению с холоднодеформированными образцами. Снижаются также $T_{\rm C}^{}, \rho_{\rm n}^{}$ и H_{C2};

б/ в результате насыщения гелием ρ_n и γ^* несколько возрастают, а θ_n и H $_{CP}(0)$ уменьшаются;

в/ послерадиационный отжиг при температурах 1150-1200 °C вызывает сильное снижение ρ_n и $H_{C2}(0)$ у образцов из $Nb_{0,8}$ Ti_{0,2}. Для образцов из $Nb_{0,97}$ Ti_{0,03} послерадиационный отжиг при температурах 1100-1150 °C приводит к возрастанию ρ_n и $H_{C2}(0)$.Предложено объяснение этих фактов;

г/ несмотря на значительные изменения структуры образцов, линейная связь между верхним критическим магнитным полем $H_{CP}(0)$ и величиной $\sqrt{\gamma^*}\rho_n$ практически не нарушается.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волков М.П. и др. ФНТ, 1978, т. 4, №1, с. 32-40.

- 2. Василев П. и др. ОИЯИ, Р8-12792, Дубна, 1979; Вопросы атомной науки и техники, 1979, т. 3, №11, с.30-35.
- Волков М.П. и др. Препринт ИАЗ им. И.В.Курчатова, ИАЗ-3245/10, М., 1980.
- 4. Bachman R. et al. Rev.Sci.Instr., 1972,43,N2,p.205.
- Савицкий Е.М. и др. В кн.: Труды 6 Всесоюзного совещания по проблеме сверхпроводящих материалов. "Наука", М., 1972, с. 87-101.

- 6. Буккель В. Сверхпроводимость. "Мир", М., 1975, с. 175.
- 7. Василев П.Г. и др. Тезисы докладов 21 Всесоюзного совещания по физике низких температур. Харьков, 1980, ч. 1, c. 82-83.

and the second second

Second States Street

the second s

· . () · · ·

an bahar ng sangan n Ng sangan n Ng sangan ng

and the second second second second second $\left(\left(t_{0} \right) + \left(t_{0} \right) \right) = \left(\left(t_{0} \right) + \left(t_{0} \right) \right) + \left(t_{0} \right) + \left($

A second sec second sec

na se a la segura de la seconda de la se Antal de la seconda de la s Antal de la seconda de la s

میں ہے ہیں جاتے ہوئے کی میں میں ایک ہوتے ہوئے کی میں ہے۔ میں ایک ایک ہوتے ہوئے کہ ایک ایک ہوتے ہوئے کہ ایک ہوتے ہوئے کہ ایک ہوتے ہوئے کہ ایک ہوتے ہوئے کہ اور ایک ہوتے ک

1 4 P

March Mathematics and Construction

taries to a sign

ADD STORES

8. Graebner J.E. et al. Phys.Rev.Lett., 1977, 39, p. 1480.

control 1. See the state

and the second second second second

Рукопись поступила в издательский отдел 12 марта 1981 года.

and the second second